

2SC3837K 2SC4082

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistors
高周波増幅用/RF Amplifier

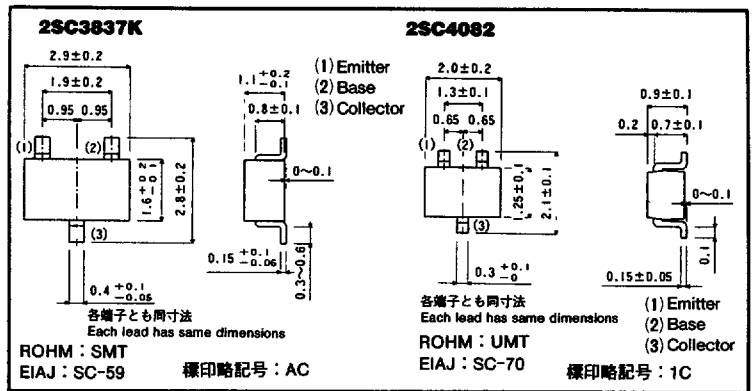
● 特長

- 1) f_T が高い。 $f_T=1.5\text{GHz}$ (Typ.)
- 2) $C_C \cdot r_{bb'}$ が小さく高利得。
 $C_C \cdot C_{bb'}=6\text{ps}$ (Typ.)
- 3) 雑音特性がよい。

● Features

- 1) High transition frequency:
 $f_T=1.5\text{GHz}$ (Typ.)
- 2) High gain with low collector to base time constant. $C_C \cdot C_{bb'}=6\text{ps}$ (Typ.)
- 3) Low level noise figure.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	18	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	3	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
コレクタ損失	P_C	150	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	30	—	—	V	$I_C=10\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	18	—	—	V	$I_C=1\text{mA}$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	3	—	—	V	$I_E=10\mu\text{A}$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	0.5	μA	$V_{CB}=10\text{V}$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	0.5	μA	$V_{EB}=2\text{V}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.5	V	$I_C/I_B=20\text{mA}/4\text{mA}$
直流電流増幅率	h_{FE}	27	—	270	—	$V_{CE}/I_C=10\text{V}/10\text{mA}$
利得帯域幅積	f_T	600	1500	—	MHz	$V_{CB}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=200\text{MHz}$
出力容量	C_{ob}	—	0.9	1.5	pF	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0\text{A}, f=1\text{MHz}$
コレクタ・ベース時定数	$C_C \cdot r_{bb'}$	—	6	13	ps	$V_{CB}=10\text{V}, I_C=10\text{mA}, f=31.8\text{MHz}$
雑音指数	NF	—	4.5	—	dB	$V_{CE}=12\text{V}, I_C=2\text{mA}, f=200\text{MHz}, R_g=50\Omega$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	L	M	N	P	Q
h_{FE}	27~56	39~82	56~120	82~180	120~270

● 標準品・標準品一覧表 (○:標準品 △:特別仕様)

Type	hFE	包装名	バルク	テーピング			
				記号	T146	T147	T106
		基本発注単位(個)	2000	3000	3000	3000	3000
2SC3837K		LMNPQ	—	○	△	—	—
2SC4082		LMNPQ	—	—	—	○	△

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

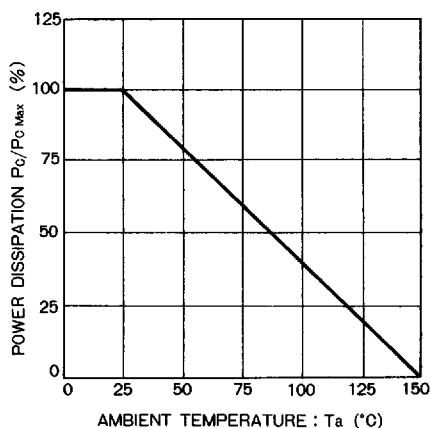


Fig.1 電力軽減曲線

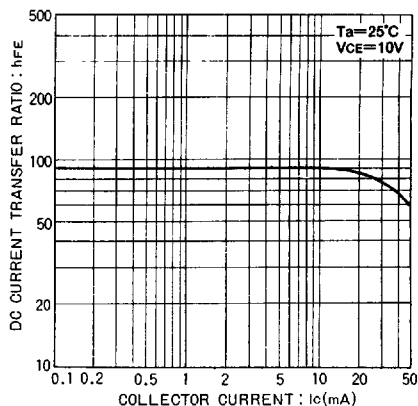


Fig.2 直流電流増幅率-コレクタ電流特性

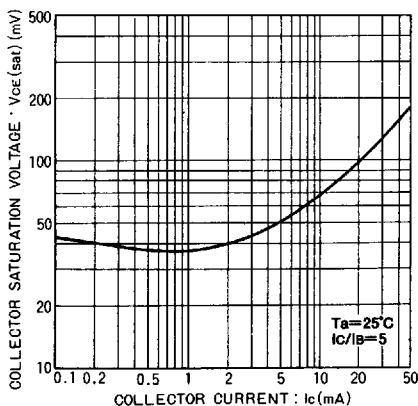


Fig.3 コレクタ・エミッタ飽和電圧
-コレクタ電流特性

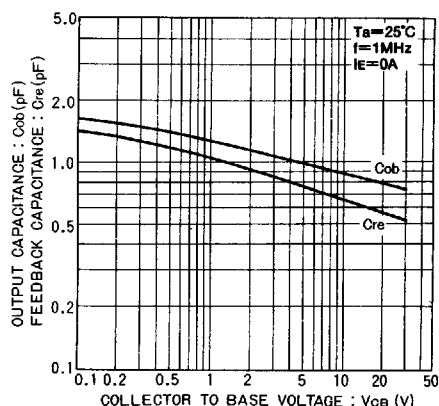


Fig.4 入出力・帰還容量-電圧特性

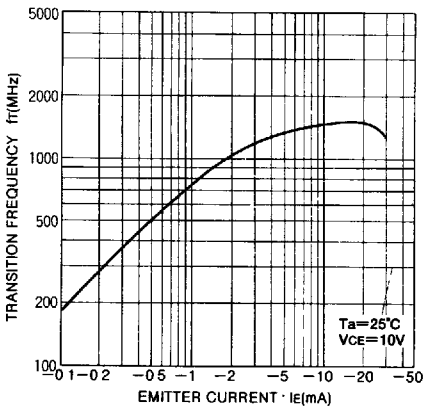


Fig.5 利得帯域幅積一エミッタ電流特性

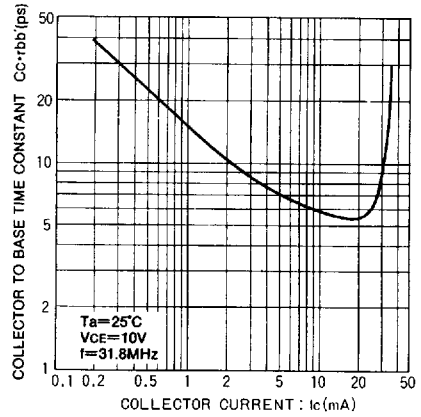


Fig.6 コレクタ・ベース時定数一コレクタ電流特性

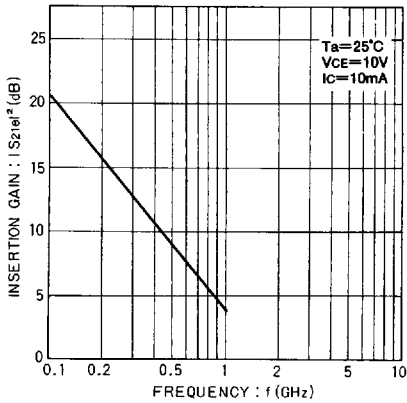


Fig.7 順方向伝達利得一周波数特性

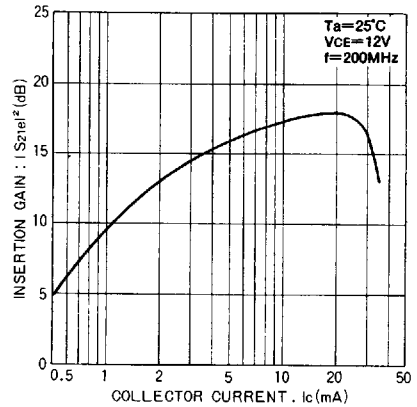


Fig.8 順方向伝達利得一コレクタ電流特性

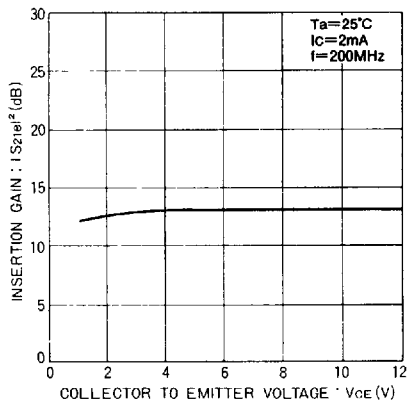


Fig.9 順方向伝達利得一コレクタ電圧特性

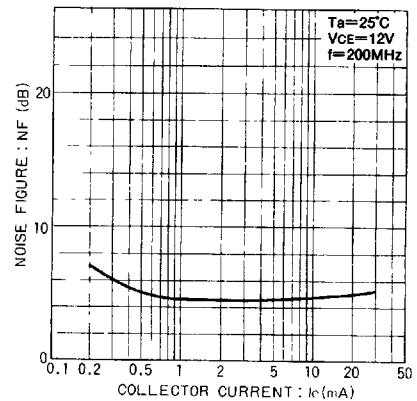


Fig.10 雑音指数一コレクタ電流特性

トランジスタ

2SCタイプ

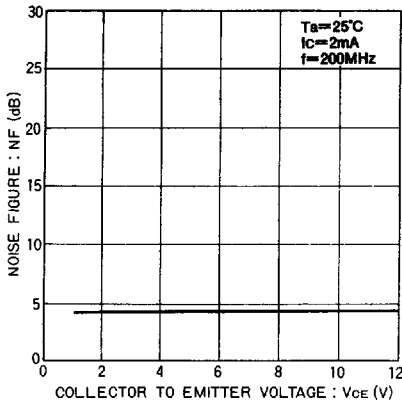
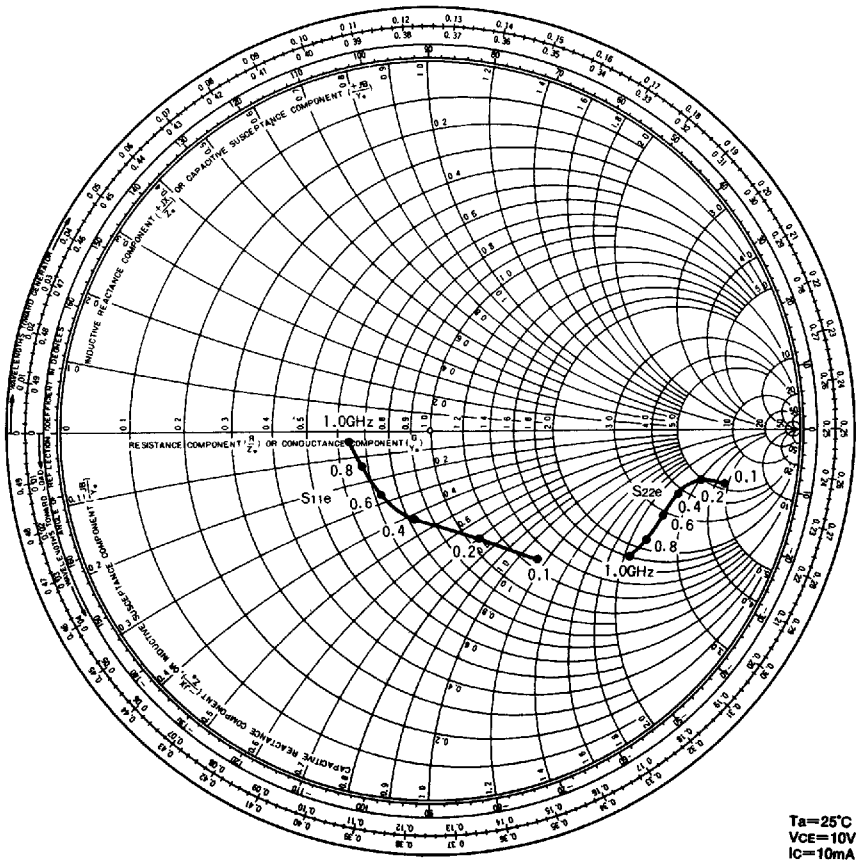


Fig.11 雑音指数—コレクタ電圧特性



$T_a = 25^\circ\text{C}$
 $V_{CE} = 10\text{V}$
 $I_C = 10\text{mA}$

Fig.12 S_{11e}, S_{22e} — 周波数特性

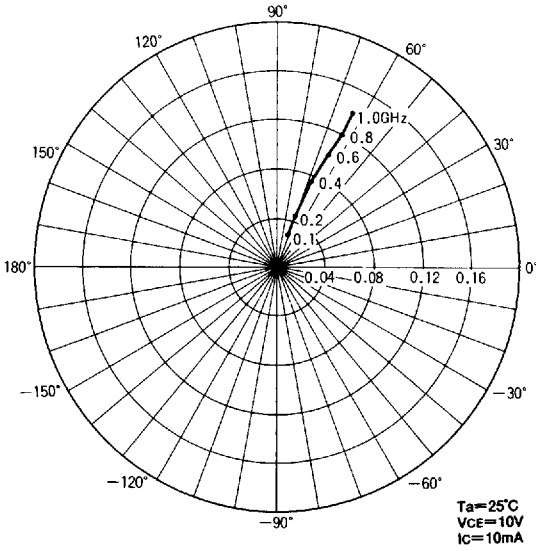


Fig.13 S12e - 周波数特性

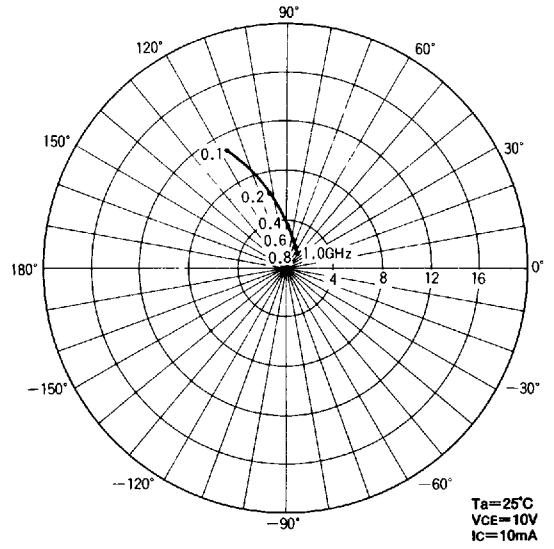


Fig.14 S21e - 周波数特性

f (MHz)	S ₁₁	∠S ₁₁	S ₁₂	∠S ₁₂	S ₂₁	∠S ₂₁	S ₂₂	∠S ₂₂
100	0.450	-52	0.026	71	10.665	116	0.801	-11
200	0.319	-67	0.044	70	6.144	101	0.733	-12
400	0.244	-102	0.076	68	3.394	86	0.683	-15
600	0.223	-129	0.101	65	2.442	74	0.664	-21
800	0.215	-155	0.122	64	1.901	63	0.649	-27
1000	0.235	-175	0.141	63	1.565	54	0.639	-33

2SC3837K TYPICAL S-PARAMETER DATA
 V_{CE}=10V, I_C=10mA, Z₀=50Ω
 S-MAGNITUDE AND ANGLES (DEGREE)

トランジスタ
2SCタイプ